

Конференция

Квантовые материалы и технологии на нанометровой шкале

26 ноября 2020 г.

Первое информационное сообщение

Глубокоуважаемые коллеги!

Федеральный исследовательский центр «Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук» и Институт физики высоких давлений им.Л.Ф. Верещагина Российской академии наук 26 ноября 2020 г. проводят вторую однодневную конференцию «Квантовые материалы и технологии на нанометровой шкале».

Тематика конференции включает в себя следующие основные направления:

- Перспективные наноматериалы и наноструктуры, полученные при высоких давлениях.
- Свойства сильно коррелированных электронных систем на наномасштабах.
- Новые квантовые технологии.
- Полупроводниковые, магнитные, сверхпроводящие наносистемы, в том числе низкоразмерные системы.

Программный комитет

В.В. Бражкин, академик РАН (ИФВД РАН) (со-председатель)
С.В. Демишев, д.ф.-м.н. (ИОФ РАН) (со-председатель)
И.В. Кукушкин, академик РАН (ИФТТ РАН)
В.В. Кведер, академик РАН (ИФТТ РАН)
Н.С. Аверкиев, д.ф.-м.н. (ФТИ РАН)
П.И. Арсеев, чл.-корр. РАН (ФИАН)
В.Н. Рыжов, д.ф.-м.н. (ИФВД РАН)
В.В. Глушков, д.ф.-м.н. (ИОФ РАН)
В.А. Давыдов, д.х.н. (ИФВД РАН)

Оргкомитет

С.В. Демишев, д.ф.-м.н. (ИОФ РАН) (председатель)
В.В. Бражкин, академик РАН (ИФВД РАН)
В.В. Глушков, д.ф.-м.н. (ИОФ РАН)
Е.В. Захарова (ИОФ РАН)
Т.В. Валянская, к.ф.-м.н. (ИФВД РАН)
Л.Б. Солодухина (ИФВД РАН)

На конференции будут заслушаны устные приглашенные доклады (регламент выступления 20-25 мин). Для молодых ученых будет предоставлена возможность принять участие в стендовой сессии, составленной из докладов, отобранных программным комитетом.

Порядок регистрации для участия в конференции и правила оформления тезисов докладов будут сообщены во втором информационном сообщении.

Список приглашенных докладчиков (предварительный)

А.С. Мельников (Институт физики микроструктур) Топологическая сверхпроводимость.

В.А. Давыдов (ИФВД РАН) Низконапряженные нанодиазиды с примесно-вакансионными оптическими центрами: синтез, исследование свойств.

Е.А. Екимов (ИФВД РАН) Размерно-контролируемый синтез нанодиазидов в гетероуглеродных системах под давлением.

А.В. Цвященко (ИФВД РАН) Изучение локальных сверхтонких взаимодействий в сильно коррелированных электронных системах методом возмущенных угловых гамма-гамма корреляций.

С.В. Демишев (ИОФ РАН). Спин-флуктуационные переходы. Что это такое и где они бывают?

Б.А. Андрущечкин (ИОФ РАН). Наноструктурирование поверхности металлов при воздействии галогенов: исследования на атомном уровне.

Н.Е. Случанко (ИОФ РАН). Динамические зарядовые страйпы в редкоземельных гекса- и додекаборидах.

Е.А. Константинова (МГУ). Динамика носителей заряда в наноструктурах на основе оксидов титана, молибдена, вольфрама и ванадия.

С.В. Стрельцов (Институт физики металлов РАН). Орбитальные степени свободы в физике конденсированного состояния.

По вопросам участия в конференции можно обращаться по электронной почте:

demis@lt.gpi.ru (С.В. Демишев) и elena.zakharova.office@gmail.com (Е.В. Захарова).